

E DIN 50453-1:2023-02 (D)

Erscheinungsdatum: 2023-01-06

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung der Ätzzraten von Ätzmischungen - Teil 1: Silicium-Einkristalle, Gravimetrisches Verfahren

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Kurzbeschreibung des Verfahrens	4
5 Geräte.....	4
6 Silicium-Substrat	5
7 Zusammensetzung der Ätzmischungen	5
8 Einflüsse auf das Messergebnis	5
8.1 Substrat-Oberfläche	5
8.2 Seitenflächen des Probekörpers	5
8.3 Kristallorientierung	5
8.4 Substratdotierung	5
8.5 Spezifische Zusammensetzung der einzelnen Ätzmischung	5
8.6 Rührgeschwindigkeit.....	6
8.7 Temperatur	6
8.8 Massendifferenz.....	6
9 Probenvorbereitung.....	6
10 Durchführung	6
11 Auswertung	8
12 Präzision des Verfahrens.....	8
13 Prüfbericht	8
Literaturhinweise	10

Bilder

Bild 1 — Versuchsaufbau zur Bestimmung der Ätzzrate von Ätzmischungen.....	8
--	---